

2SD199

シリコン NPN 三重拡散メサ型/Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

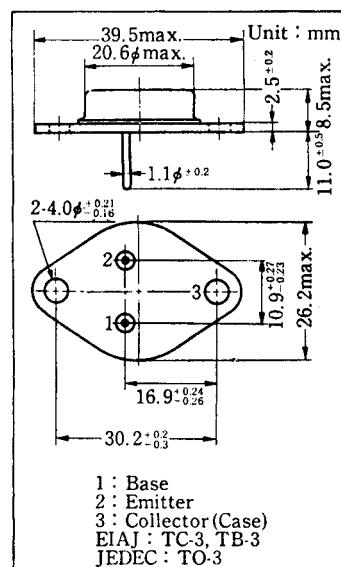
電源直結式垂直偏向出力用/Line-Operated Vertical Deflection Output

特徴/Features

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CE} が高い。/High V_{CE}
- コレクタ電流 I_C が大きい。/High I_C

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	800	V
コレクタ・エミッタ電圧 ($R_{BE} \leq 220\Omega$)	V_{CE}	700	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	0.5	A
コレクタ電流	I_C	0.25	A
コレクタ損失 ($T_c=75^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE}	$I_C=100\text{mA}$, $R_{BE}=220\Omega$, $L=1.5\text{H}$	700			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	$I_E=5\text{mA}$, $I_C=0$	6			V
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=800\text{V}$, $I_E=0$			1	mA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=0.02\text{A}$	25			
	h_{FE2}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=0.2\text{A}^{**}$	30			
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=0.1\text{A}$		7		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.5\text{A}$, $I_B=0.05\text{A}^{**}$			10	V

** パルス測定/Pulse Test